(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11)特許出願公表番号 特表2003-515665 (P2003-515665A)

(43)公表日 平成15年5月7日(2003.5.7)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	FΙ			テーマコード(参考)
C09K	11/59	CQH	C09K 1	1/59	CQH	4H001
C09C	1/00		C 0 9 C	1/00		4 J O 3 7
C09K	11/66		C09K 1	1/66		

審查請求 未請求 予備審查請求 未請求(全 20 頁)

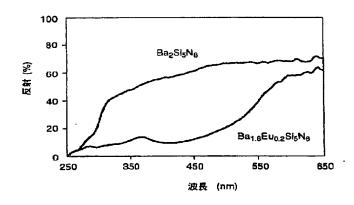
(21)出願番号 特願2001-541319(P2001-541319)	(71)出願人 オスラム オプト セミコンダクターズ
(86) (22)出顧日 平成12年11月30日(2000.11.30)	ゲゼルシャフト ミット ペシュレンクテ
(85)翻訳文提出日 平成13年7月27日(2001.7.27)	ル ハフツング
(86)国際出願番号 PCT/EP00/12047	Osram Opto Semikond
(87)国際公開番号 WO01/039574	uctors GmbH
(87)国際公開日 平成13年6月7日(2001.6.7)	ドイツ連邦共和国 レーゲンスプルク ヴ
(31)優先権主張番号 99123747.0	ェルナーヴェルクシュトラーセ 2
(32)優先日 平成11年11月30日(1999.11.30)	(74)代理人 弁理士 矢野 敏雄 (外4名)
(33)優先権主張国 欧州特許庁(EP)	
(81)指定国 EP(AT, BE, CH, CY,	
DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, I	
T, LU, MC, NL, PT, SE, TR), CA, C	
N, HU, JP, KR, US	
	最終頁に続く

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 昼光の蛍光を有する顔料

(57)【要約】

ニトリドシリケートタイプMx Si, N:: Eu [ここ で、Mは基Ca、Sr、Baの群から選択される少なく とも1つのアルカリ土類金属であり、かつz=2/3x+4/3 yである]のホスト格子を有している顔料、特 に黄色から赤色を放射する発光材料。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 昼光の蛍光を有する顔料において、ニトリドシリケートタイプ M_x S i y N z : E u [ここで、MはC a 、S r 、B a 、Z n の群から選択される少なくとも1つのアルカリ土類金属であり、かつ z = 2/3 x + 4/3 y である] のホスト格子を有することを特徴とする、昼光の蛍光を有する顔料。

【請求項2】 x = 2及びy = 5である、請求項1記載の顔料。

【請求項3】 x=1及びy=7である、請求項1記載の顔料。

【請求項4】 Mがストロンチウムである、請求項1記載の顔料。

【請求項5】 Mが前記群の少なくとも2つの金属の混合物である、請求項1記載の顔料。

【請求項6】 Siが完全に又は部分的にGeにより置換されている、請求項1記載の顔料。

【請求項7】 前記顔料が青ないし緑色のスペクトル領域内で吸収している 、請求項1記載の顔料。

【請求項8】 前記顔料が黄色ないし赤色のスペクトル領域内で蛍光である 、請求項7記載の顔料。

【請求項9】 着色顔料としての請求項1記載の顔料の使用。

【請求項10】 光源により励起し、黄色ないし赤色のスペクトル領域内で 放射する蛍光体としての請求項1記載の顔料の使用。

【発明の詳細な説明】

[0001]

技術分野

本発明は、昼光の蛍光を有する顔料及び殊に専ら青から緑色の光を吸収しかつ 昼光又は人工光源による励起下で黄色から赤色のスペクトル領域内で蛍光を放射 する顔料に関する。他のスペクトル領域における、特にUVにおける更なる吸収 も可能である。特に、そのような顔料は、光源、特に発光ダイオード(LED) 又は電灯のための蛍光体として使用されることができる。顔料は、希土類で活性 化された窒化ケイ素のクラスに属する。

[0002]

背景技術

Eu²+でドープされた材料には、通常UV-青色放射が観察される(Blasse 及びGrabmeier: Luminescent Materials, Springer Verlag, Heidelberg, 1994)。幾つかの研究は、可視スペクトルの緑及び黄色の部分における放射も可能で あることを示している (Blasse: Special Cases of divalent lanthanide emiss ion, Eur. J. Solid State Inorg. Chem. 33 (1996), p. 175; Poort, Blokpoel and Blasse: Luminescence of Eu² + in Barium and Strontium Aluminate an d Gallate, Chem. Mater. 7 (1995), p. 1547; Poort, Reijnhoudt, van der Ku ip, and Blasse: Luminescence of Eu^{2 +} in Silicate host lattices with Al kaline earth ions in a row, J. Alloys and Comp. 241 (1996), p. 75) 。こ れまで、赤色のEu2+ルミネセンスは若干の例外的な場合にのみ、例えばアル カリ土類金属硫化物及び岩塩型の関連する格子 (Nakao, Luminescence centers of MgS, CaS and CaSe Phosphors Activated with Eu² + Ion, J. Phys. Soc. Jpn. 48(1980), p. 534) 、アルカリ土類金属チオ没食子酸塩(Davolos, Garcia , Fouassier, and Hagenmuller, Luminescence of Eu² + in Strontium and Ba rium Thiogallates, J. Solid. State Chem. 83 (1989), p. 316) 及び若干のホ ウ酸塩 (Diaz and Keszler: Red, Green, and Blue Eu² + luminescence in so lid state Borates: a structure-property relationship, Mater. Res. Bull. 31(1996), p. 147) において観察される。アルカリ土類金属ケイ素窒化物でのE

 $u^2 + \nu$ ミネセンスは、これまでMgSiN2:Eu (Gaido, Dubrovskii, and Zykov: Photoluminescence of MgSiN2 Activated by Europium, Izv. Akad. Nauk SSSR, Neorg. Mater. 10 (1974), p. 564; Dubrovskii, Zykov and Chernovets: Luminescence of rare earth Activated MgSiN2, Izv. Akad. Nauk SSSR, Neorg. Mater. 17 (1981), p. 1421) 及びMg1-xZnxSiN2:Eu (Lim, Lee, Chang: Photoluminescence Characterization of Mg1-xZnxSiN2:Tb for Thin Film Electroluminescent Devices Application, Inorganic and Organic Electroluminescence, Berlin, Wissenschaft und Technik Verlag, (1996), p. 363) のみに報告されていた。双方ともスペクトルの緑及び緑/青色の部分のEu2+ルミネセンスが見いだされた。

[0003]

ニトリドシリケートタイプの新しいホスト格子は、アルカリ土類金属イオン(M=Ca、Sr及びBa)が組み込まれた架橋SiN4四面体の3次元ネットワークをベースとするものである。そのような格子は、例えばCa2Si5N8(Schlieper and Schlick: Nitridosilicate I, Hochtemperatursynthese und Kristallstruktur von Ca2Si5N8, Z. anorg. allg. Chem. 621, (1995), p. 1037)、Sr2Si5N8及びBa2Si5N8(Schlieper, Millus and Schlick: Nitridosilicate II, Hochtemperatursynthesen und Kristallstrukturen von Sr2Si5N8 and Ba2Si5N8, Z. anorg. allg. Chem. 621, (1995), p. 1380)及びBaSi7N1の(Huppertz and Schnick: Edge-Sharing SiN4 tetrahe drain the highly condensed Nitridosilicate BaSi7N1の,Chem. Eur. J. 3 (1997), p. 249)である。格子のタイプは第1表に挙げられている。

[0004]

硫化物ベースの蛍光体(例えばアルカリ土類金属硫化物)は、照明用途、特に LED用途にとってあまり望ましくない、それというのも、これらは封入する樹脂系と相互作用し、かつ部分的に加水分解作用を受けるからである。赤色を放射するEu²+で活性化されたホウ酸塩は、LEDの操作温度で、ある程度までの 温度消光を既に示す。

[0005]

発明の開示

従って、先行技術の不利を取り除くことが本発明の対象である。昼光の蛍光の 顔料を提供することが本発明の別の対象である。高い化学的安定性及び熱安定性 と共に、約200~500nm、好ましくは300~500nmの波長で励起可 能な、黄色から赤色を放射する発光材料を提供することも、更なる対象である。

[0006]

少なくとも100℃までの特に高い安定性は、LED用途にとって非常に望ま しい。その典型的な操作温度は、約80℃である。

[0007]

これらの対象は請求項1の特徴部によって達成される。有利な実施態様は従属 請求項中に見いだされうる。

[0008]

新しい顔料は、青ー緑スペクトル領域内で少なくとも吸収を示す。更に、これらは吸収下に蛍光放射を示す。これらのEu²+でドープされた発光材料は、黄色から赤色のスペクトル領域内での放射、特に長波長の赤、オレンジ又は黄色の放射を示す。これらの顔料は、ホスト格子としてアルカリ土類金属ケイ素窒化物材料をベースとしている。これらは、蛍光体として使用される場合には、特にLED用途に極めて有望である。これまで白色LEDは、青色を放射するダイオードを、黄色を放射する蛍光体と組み合わせることによって実現されていた。そのような組合せは、乏しい演色のみを有する。はるかに良好な性能は、多色(例えば赤ー緑ー青)系を使用することによって達成されてもよい。典型的には、新しい材料は、その放射極大が約520nmである緑色を放射する(又は黄色を放射する)蛍光体、例えばアルミン酸ストロンチウムSrAl2O4:Eu²+と共に使用されてもよい。

[0009]

詳細には、昼光の蛍光を有している新しい顔料は、ニトリドシリケートタイプ M_x S i $_y$ N $_z$: E u [ここで、MはC a 、S r 、B a の群から選択される少な くとも 1 つのアルカリ土類金属でありかつ z=2/3 x+4/3 y である] のホスト格子を使用する。窒素の組み込みは、共有結合及び配位子場分裂の割合を増

大させる。結果として、これは酸化物格子と比較してより長波長に励起及び放射 バンドの著しいシフトをもたらす。

[0010]

好ましくは、顔料はx = 2及びy = 5であるタイプのものである。好ましい別の実施態様において、顔料はx = 1及びy = 7であるタイプのものである。

[0011]

好ましくは、顔料中の金属Mはストロンチウムである、それというのも、生じる蛍光体が、黄色から赤色の相対的に短い波長を放射しているからである。こうして、効率は他の選択された金属Mの大部分と比較してかなり高い。

[0012]

別の実施態様において、顔料は成分Mとして異なる金属の混合物、例えばCa(10原子%)をBa(バランス)と一緒に、使用する。

[0013]

これらの材料は、UV及び青色の可視スペクトル(450nmを上回るまで) において高い吸収及び良好な励起、高い量子効率及び100℃までの低い温度消 光を示す。

[0014]

品物に色をつけるための顔料として、又は特に一つ以上の他の蛍光体(赤及び緑)と共に、青色光を放射する一次源を有しているルミネセンス変換LEDのための蛍光体として使用されることができる。

[0015]

詳細な実施熊様

Eu2O3 (純度99.99%を有する)、又はEu金属(99.99%)、Ba金属(>99%); Sr金属(99%)、Ca3N2 (98%)又はCa粉末(99.5%)及びSi3N4 (99.9%)を、商業的に入手可能な出発材料として使用した。Ba及びSrを、窒素雰囲気下での550及び800℃での焼成により窒化した。その後、Ca3N2又は窒化されたBa、Ca又はSrを、乳鉢中で粉砕し、かつ窒素雰囲気下にSi3N4と化学量論的に混合した。Eu-濃度は、アルカリ土類金属イオンに対して10原子%であった。粉末にした

混合物を、窒素/水素雰囲気下で水平管炉中で約 $1300\sim1400$ ℃でモリブデンるつぼ中で焼成した。焼成後、粉末を、粉末X線回折(Cu、 $K\alpha$ -線)によって特性決定し、これは全ての化合物が形成されたことを示した。

[0016]

ドープされていないBa2Si5N8、Ca2Si5N8及びBaSi7N1のは、灰色がかった白色粉末である。これらのドープされていない、希土類で活性化された窒化ケイ素は、可視範囲($400\sim650$ nm)における高い反射及び250 ~300 nmの間の反射の強い低下を示している(図1及び2)。反射率の低下はホストー格子吸収に起因している。Euでドープされた試料は、オレンジー黄色であるBaSi7N1の:Euを除いて、オレンジー赤色である(第1表)。強い着色は、Eu2+でドープされ、希土類で活性化された窒化ケイ素に特有のものであり、かつこれらの材料を興味深いオレンジー赤色の顔料にする。Ba2Si5N8:Euの反射スペクトルの典型的な例は、Euのために吸収がホストー格子吸収に重ね合わされ、かつ500 ~550 nmまで広がることを示している(図1)。これは、これらの化合物の赤ーオレンジ色を説明する。類似した反射スペクトルは、Sr2Si5N8:Eu及びCa2Si5N8:Eu

[0017]

BaSi7N10:Euでは、Euの吸収は可視部分(図2)をそれほど離れておらず、これはこの化合物のオレンジー黄色を説明する。

[0018]

全ての試料は、可視スペクトルのオレンジー赤の部分において放射極大を有しているUV励起下に有効なルミネセンスを示している(第1表参照)。放射スペクトルの2つの典型的な例は、図3及び4において参照されうる。これらは、放射がBaSi7N10:Euの660nmまでの極大を有している超長波長(Eu²+放射のため)であることを示している(図4)。励起バンドは、N³-を含んでいる格子に期待され得るように、低エネルギーでのEu²+の5dバンドの重心及びEu²+の5dバンドの強い配位子場分裂を生じる低いエネルギーで観察される(van Krevel、Hintzen、Metselaar、and Meijerink: Long Waveleng

th Ce 3 + -luminescence in Y-Si-O-N Materials, J. Alloys and Comp. 168 (1 998) 272) $_{\circ}$

[0019]

これらの材料は、低エネルギー励起バンドのために、青色光を赤色光に変換することができるので、これらが、例えば、赤色、黄色及び/又は緑色を放射する 蛍光体と組み合わせた一次の青色を放射するLED(典型的にはGaN又はIn GaN)をベースとする、白色光源に適用されてもよい。

[0020]

【表1】

第1表:

化合物	結晶構造	色	放射極大 (nm)*
Ca ₂ Si ₅ N ₈ :Eu	半斜晶系	オレンジ-赤	600 ~ 630
Sr ₂ Si ₅ N ₈ :Eu	斜方晶系	オレンジ-赤	610 ~ 650
Ba ₂ Si ₅ N ₈ :Eu	斜方晶系	オレンジ-赤	620 ~ 660
BaSi ₇ N ₁₀ :Eu	単斜晶系	オレンジ-黄	640 ~ 680

[0021]

*製造条件及び活性化剤の濃度に依存しており; Eu-濃度の典型的な値は、アルカリ土類金属イオンMと比較して1~10%の間を変化しうる

これらの放射極大は、長波長側に異常に離れる。特別な1つの例はタイプSr1. 8 E u 0. 2 S i 5 N 8 の蛍光体である。その放射スペクトルは図5 に示されている。

[0022]

Mを現実化するための別の実施態様はZnの使用である。これは、完全に又は 部分的にBa、Sr又はCaに置換することができる。

[0023]

完全に又は部分的にSiを置換するための更なる実施態様はGeである。具体的な実施態様は、Sri. 8 Euo. 2 Ge 5 N 8 である。

[0024]

更に、複数の特別な例が、次に研究されている:

[0025]

室化物合成のためには、出発材料は Si_3N_4 (99.9%(主に $\alpha-$ 相)、 Alfa Aesar)、Sr金属(樹枝状片99.9%、Alfa Aesar)及び Eu_2O_3 (4N)である。Sr金属は窒化されなければならず、かつ Eu_2O_3 の代わりに Eu金属を使用する場合には、これも窒化されなければならない。

[0026]

 $Sr金属を、アルゴングローブボックス中で、アガース (agath) 乳鉢中で手で粉砕しかつ<math>N_2$ 下に800 ℃で窒化する。これは、80%を上回る窒化をもたらす。

[0027]

再び粉砕した後に、Si3N4及びEu2O3と共に、窒化された金属を粉砕し、かつグローブボックス中で再び手で混合する。この混合物の加熱は、典型的には以下のパラメータを有する:

800℃まで18℃/分、

800℃で5時間

Tend (1300~1575°C) まで18°C/分

Tend (1300~1575℃) で5時間

 H_2 (3. 75%) / N_2 4001/h

Ca2Si5N8:Eu2+試料を、出発材料としてCa3N2で製造した。

[0028]

全ての試料の概要は、第1表に与えられている。典型的には、試料をまず最初に800℃で加熱し、ついで、これらを高められた温度で(1300~1600

[0029]

【表2】

第1表 : (Ca,Sr)₂Si₅N₈:Eu²⁺ 試料の加熱サイクルのパラメータ

コード	Ca/sr	Eu ²⁺ (%)	時間 1 (h)	温度 1 (°C)	時間 2 (h)	温度 2 (°C)
EC/HU 31/00	Ca	10	5	800	5	1400
EC/HU 42/00	Ca	1	5	800	5	1565
EC/HU 41/00	Ca0.4Sr1.4	10	5	800	5	1565
EC/HU 62/00	Sr	1	5	800	5	1400
EC/HU 63/00	Sr	2	5	800	5	1400
EC/HU 64/00	Sr	3	5	800	5	1400
EC/HU 65/00	Sr	5	5	800	5	1400
EC/HU 68/00	Sr	В	5	800	5	1400
EC/HU 67/00	Sr	10	5	800	5	1400

[0030]

この加熱後に得られる試料は、 $Sr_2Si_5N_8$ 試料を含んでいる10%のE u^2+ のために、濃いオレンジ色を示す。 Eu^2+ が少なくなるにつれて、色はより弱くなる。Ca 試料は黄ーオレンジ色を有する。

[0031]

興味深い別の特徴も存在ずる:粉末粒子は、約 $0.5\sim5~\mu$ mの間の平均粒度 d $5~\sigma$ で極めて小さく、典型的な値が d $5~\sigma=1.3~\mu$ mである。小さい粒度は、発光材料を有しているLEDの加工のために有利である。例えば、これらは樹脂中で均質な分布を可能にする。

[0032]

【表3】

第2表:(Ca,Sr)₂Si₅N₀:Eu²+ 試料の光学的データ

コード	Ca/Sr	Eu ²⁺ (%)	放射 極大 (nm)	反射 400 (%)	反射 460 (%)	QE (%)	×	У
EC/HU 31/00	Ca	10	619	12	19	26	0.600	0.396
EC/HU 42/00	Ca	1	603	47	58	37	0.555	0.435
EC/HU 41/00	Ca0.4 Srl.4	10	660	17	22	59	0.636	0.,354
EC/HU 62/00	Sr	1	609	5 3	58	70	0.602	0.393
EC/Hu 63/00	Sr	2	618	43	48	73	0.615	0.381
EC/Hu 64/00	Sr	3	621	36	41	72	0.622	0.374
EC/Hu 65/00	Sr	5	624	26	32	67	0.632	0.365
EC/HU 66/00	Sr	8	636	21	26	67	0.641	0.356
EC/HU 67/00	Sr	10	644	17	22	64	0.642	0.354

[0033]

第2表に関して、全ての試料を、典型的にはまず最初に、すでに上記で概説されるように、第一サイクル(例えば800℃、5時間)において加熱した。

[0034]

第2表に含まれているのは、放射極大の位置、平均波長、400及び460nmでの反射、量子効率及び最終的なx及びy色座標である。

[0035]

第2表からは、純粋なCa 試料がSr 試料ほど有利でないことが引き出されうる。Sr-Ca 化合物が、純粋なSr 化合物のそれよりも大きい放射波長を有することは意外である。

[0036]

特別な例は、図 6~8 に示されている。図 6 は、3% E u の割合及び 7 2% の量子効率を有している試料 H U 6 4 / 0 0 (S r 2 S i 5 N 8 : E u 2 +) のエネルギー分布 (任意の単位)及び反射 (パーセント)を示している。図 7 は、5% E u の割合及び 6 7%の量子効率を有している試料 H U 6 5 / 0 0 (S r 2 S i 5 N 8 : E u 2 +)のエネルギー分布 (任意の単位)及び反射 (パーセント)を示している。図 8 は、1% E u の割合及び 3 7%の量子効率を有している試料 H U 4 2 / 0 0 (C a 2 S i 5 N 8 : E u 2 +)のエネルギー分布 (

任意の単位)及び反射 (パーセント)を示している。

【図面の簡単な説明】

【図1】

ドープされていないBa2Si5N8及びBa2Si5N8:Euの拡散反射スペクトル図。

【図2】

ドープされていないBaSi7N10及びBaSi7N10:Euの拡散反射スペクトル図。

【図3】

Ba2Si5N8:Euの放射スペクトル図。

【図4】

BaSi7N10:Euの放射スペクトル図。

【図5】

Sr2Si5N8:Euの一実施態様の放射スペクトル図。

【図6】

Sr2Si5N8:Euの一実施態様の放射スペクトル図。

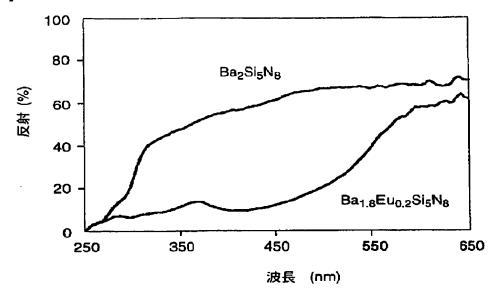
【図7】

Sr2Si5N8:Euの一実施態様の放射スペクトル図。

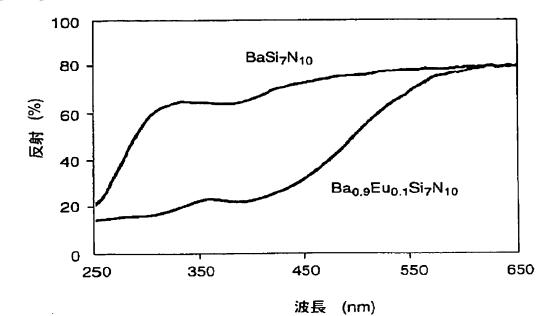
【図8】

Ca2Si5N8:Euの放射スペクトル図。

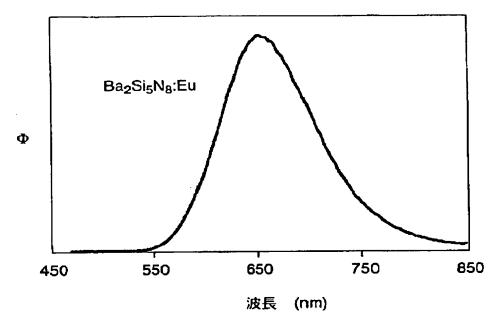
【図1】



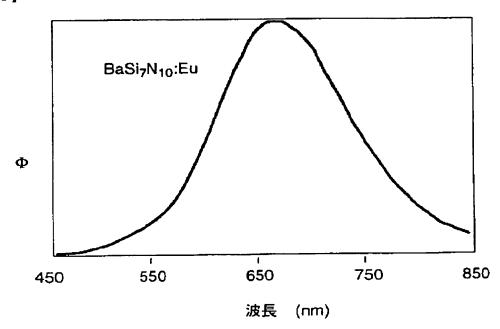




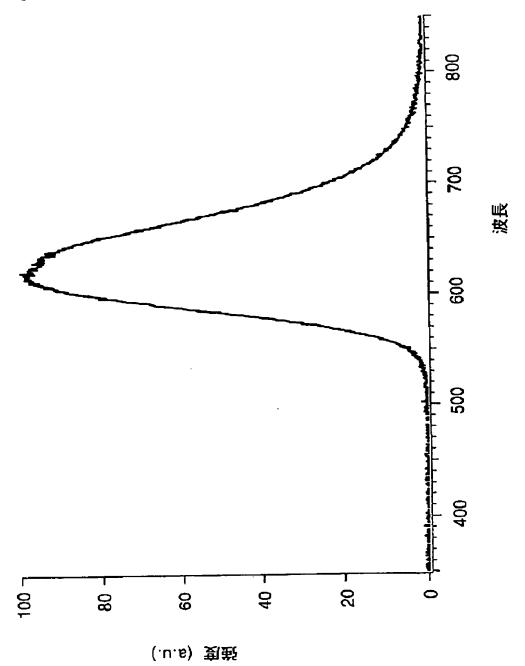
【図3】



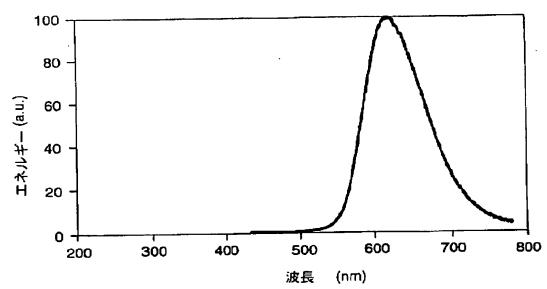
【図4】

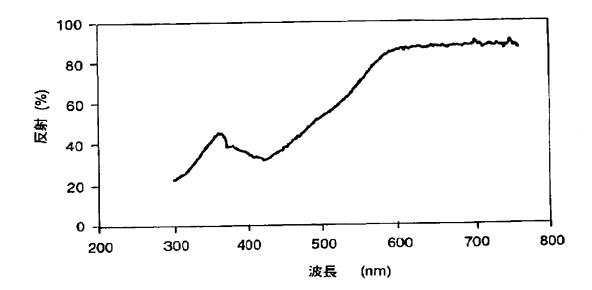




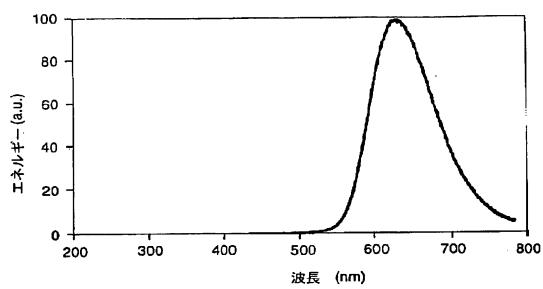


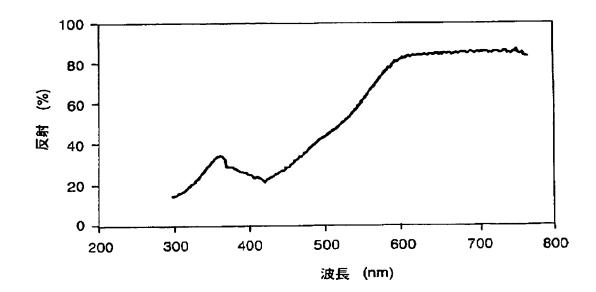




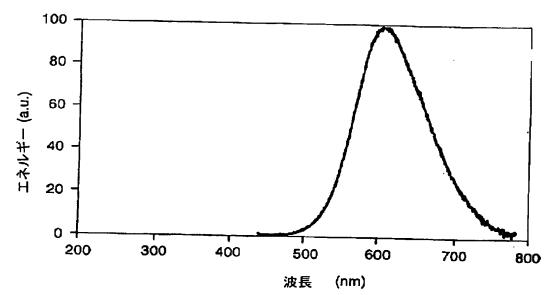


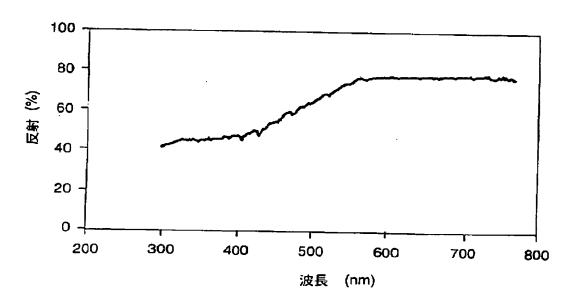












【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT in wonat Application No PCT/EP 00/12047 A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 C09K11/79 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system tollowed by classification symbols) IPC 7 C09K Documentation searched other tran minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) INSPEC. WPI Data, PAJ, EPO-Internal, IBM-TDB, CHEM ABS Data C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. SOON-SEOK LEE ET AL: "Development and 1-10 A luminescent characteristics of CaSiN/sub 2/ based phosphors" JOURNAL OF THE INSTITUTE OF ELECTRONICS ENGINEERS OF KOREA D, OCT. 1999, INST. ELECTRON. ENG. KOREA, SOUTH KOREA, vol. 36-D, no. 10, pages 31-36, XP002136109 ISSN: 1226-5845 page 31 Further documents are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in annex. Special categories of cited documents : 'T' later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but clied to understand the principle or theory underlying the invention *A* document dofining the general state of the art which is not considered to be of particular relovance "E" earlier document but published on or after the international filing data "X" document of particular retevance; the chârect invention cannot be considered about or cannot be considered to throthe an inventive step when the document is taken alone "L" document which may throw doubts on priority claims) or which is clied to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "Y" document of particular reference; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combinetion being obvious to a person skilled in the eff. "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means. *P* choument published prior to the international filing date but taler than the priority date claimed "&" document member of the same patent family Date of mailing of the international search report Date of the actual completion of the international search 19/03/2001 12 March 2001 Name and mailing address of the EA Authorized officer European Patera Office. P. 8. 5818 Patentinan 2 NL - 2280 HV Ripudik Tal. (+37-70) 340-2940, Tx. 31 661 upo ni, Fax (+31-70) 340-3016 Drouot-On1llen, M-C

Form PCT/ISA/210 (second shoot) (July 1982)

1

フロントページの続き

- (72)発明者 ハー テー ヒンツェン
 オランダ国 エムベー エイントホーフェ
 ン エステーオー 2.26 ピーオーボッ
 クス 513 エイントホーフェン ユニヴ
 ァーシティ オブ テクノロジー ラボラ
 トリー オブ ソリッド ステイト アン
 ド マテリアルズ ケミストリー
- (72) 発明者 イェー ウェー ハー ファン クレーフェル
 オランダ国 エムベー エイントホーフェン エステーオー 2.41 ピーオーボックス 513 エイントホーフェン ユニヴァーシティ オブ テクノロジー ラボラトリー オブ ソリッド ステイト アンド マテリアルズ ケミストリー
- (72) 発明者 ヘー ボッティ
 オランダ国 エムアー フェンロー ピー
 オーボックス 101 オーセ テクノロジ
 ーズ ベスローテン フェンノートシャップ ディパートメント デーペーエスーエ
 ーペー1
- F ターム(参考) 4H001 CA04 XA07 XA14 XA20 XA30 XA32 XA38 XA56 YA63 4J037 AA17 EE17